INDUCTION PLASMA TORCH

Publication number: JP5135896 Publication date: 1993-05-01

Inventor: YOMO KUNIO: YAMAJI NOBUYUKI; OKADA JUN;

EMIRIO FUJIWARA; MURATA HIROYASU;

TACHIBANA HIDEHISA

Applicant: SANSHA ELECTRIC MFG CO LTD

Classification:
- international:

C23C4/00; B23K10/00; C04B35/583; H05H1/30; C23C4/00; B23K10/00; C04B35/583; H05H1/26; (IPC1-

7): C23C4/00; H05H1/30

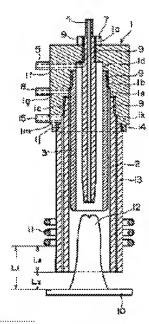
- European:

Application number: JP19910323751 199111111 Priority number(s): JP19910323751 199111111

Report a data error here

Abstract of JP5135896

PURPOSE:To execute homogeneous thermat spraying without externat influence by generating horizontally balanced plasma flame in melting and thermally spraying powder on an induction plasma forch. CONSTITUTION:A carrier gas introduction tube 4 made of a boron nitride sintered body, an intermediate tube 3, an outer tube 2, and a cooling tube 13 are successively and concentrically engaged with and threadably attached to a cylindrical support 1 in which multistage-concentrical inserting holes 1a-1e, and 1j, 1k made by a boron nitride sintered body as a raw material are formed in the cylindrical support.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出額公開番号

特開平5-135896

(43)公開日 平成5年(1993)6月1日

(51) Int.CL⁵

識別記号 庁內整理番号 9014-2G

FI

技術表示箇所

H 0 5 H 1/30 C 2 3 C 4/00

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

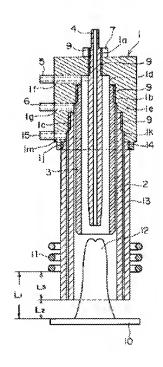
(21)出顯番号	特級平3-323751	(71)出級人 600144393
		株式会社三社幣機製作所
(72)発明者 四方 大阪 (72)発明者 山地 大阪 (72)発明者 山地 大阪 (72)発明者 山地	平成3年(1991)11月11日	大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3
		(72)発明者 四方 邦夫
		大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3
		株式会社三社常機製作所内
		(72)発明者 山地 指華
		大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3
		株式会社三社電機製作所內
	(72)発明者 岡田 贈	
		大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3
		株式会社三社常模製作所内
		(74)代理人 弁理士 田中 浩 (外2名)
		第3頁的最

(54) 【発明の名称】 インダクションプラズマトーチ

(57) 【要約】

【目的】 インダクションプラズマトーチによる粉体の 溶験、溶射に当たって、左右にバランスのとれたプラズ マ炎を発生させるとともに、外部からの影響を受けるこ となく均質な溶射を行なう。

【構成】 窒化はう素焼結体を素材として内部に多段の 同心円状抑着孔1 a乃至1 e と1 j および1 k を形成し た円筒状支持体1に窒化ほう素焼結体を用いて作ったキ ャリアガス導入管4、中間管3、外側管2、冷却管13 を順次同心円状に嵌合螺着させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 空化ほう素焼結体よりなり、内部に多段 の同心円状挿着孔を形成した円筒状支持体に、窒化ほう 素焼結体製のキャリアガス導入管、中間管、外側管およ び冷却管を順次嵌合螺着させるとともに、前記支持体内 の中間管、外側管および冷却管の先端に該管に対して接 線方向にガスを導入するガス供給管を嵌合螺着したこと を特徴とする四層構造のインダクションブラズマトー 手。

管の外部に設けた誘導コイルの下端から20mg以上離れ ていることを特徴とする請求項1記載の四層構造のイン ダクションプラズマトーチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、誘導結合型プラズマ 内でセラミックスや金属等の粉体を効率よく加熱し、溶 解して噴射でき、主として溶射に使用されるインダクシ ョンプラズマトーチに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、インダクションプラズマトーチと しては、透明石英で形成された外側管。中間管、キャリ アガス導入管からなる三重構造のトーチに水冷誘導コイ ルを設けたものが多く用いられている。本来、インダク ションプラズマトーチを用いて被溶射物上に満足できる 熔融皮膜を形成させるためには、プラズマ奏を完全に左 おにパランスよく発生させて、供給される粉体を完全導 融させることが必要であり、このためにはトーチの構成 において前記各管が完全に同心円状に形成されているこ とが必要である。

【0003】しかしながら、石英製の外側管、中間管、 キャリアガス導入管の各管を用いて完全に関心円状のト 一チを構成することは非常に難しいとされている。

【0004】 本発明者らはこのような状況に鑑みて、さ きに窒化ほう素の焼結体を素材として用いた完全に同心 円状のインダクションプラズマトーチを模案した。脚 ち、窓化ほう素焼結体よりなり、内部に多段の同心円状 挿着孔を形成した円筒状支持体に、窒化はう素焼結体製 のキャリアガス導入管、中間管および外側管を順次嵌合 先端に該管に対して接線方向にガスを導入するガス供給 管を嵌合螺着した構造のインダクションプラズマトーチ である。

【0 0 0 5】 このトーチの構成を関2の総断面関で説明 すると、図において1は窒化ほう素焼結体を加工して得 た円筒形状の支持体である。この支持体1の内部には1 a~1eの多段の挿着孔が支持体1を旋盤等にて孔派 エ、ネジ切りを繰返すことにより伺心円状に設けられて おり、これらの挿着孔にキャリアガス導入管4、中間管 3、外側管2が嵌合螺着により固定されている。

【0006】この円筒状支持体上に対する挿着孔の形成 は、まず、キャリアガス導入管4を貫通挿着するための 挿着孔1aを支持体1に賞選形成し、次に中間管3の挿 着孔1 bを支持体1のほぼ中間の位置に挿着孔1 aと同 心円状に形成し、その後外側管2の挿着孔1cを形成す る。次いで中間管3支持用棒蓄孔1bの上方に中間管3 の内径と同じか又は若干小径の挿着孔1 dを、また外側 管2支持用挿着孔1cの上方に外側管2の内径と同じか 义は若干小径の挿着孔 1 eを形成する。

【翻求項2】 外側管および冷却管の下端の位置が冷却 10 【0007】このようにして内部に同心円状の1a~1 eを形成した零化ほう素焼結体製の円筒状支持体1に、 何じく窒化ほう素焼結体を用いて夫々円筒形状に作った 外観管2、中間管3、キャリアガス導入管4およびブラ ズマガス供給管6、シースガス供給管6を取り付けるに は、まず挿着孔1 a に下方からキャリアガス導入管4を 貰滴させ、ネジ9で螺着固定する。その後間様にして挿 着孔1bに中港管3を、挿着孔1cに外側管2を順次螺 着し、次いでプラズマガス供給管5、シースガス導入管 6を夫々様着孔1d、1eに接線方向に設けたネジ部1 20 f、1gに挿着し螺着する。なお、外側管2の内周面と 中間管3の外周頭との間は供給するガスの速度を増して 希却効率を高めるため約1mmの小間線となっている。

> 【0008】 このようにして窒化ほう素焼結体を用いて 河心円状に構成したインダクションプラズマトーチを用 い、プラズマガス供給管5からキャリアガス導入管4と 中間管3との間にアルゴンガスなどのブラズマガスを5 リッター/分で供給し、シースガス供給路6から中間管 3と外側管2との間にアルゴンガスなどのシースガスを 20リッター/分で供給し、キャリアガス導入管4から 30 キャリアガスとともに粒径5~100 u m の粉体を1 g / 分供給する状態で透導コイル11に5KW、13、5 6MH 2の高層波を印加すると、左右によくバランスの とれた正常なプラズマ炎12が発生して粉体が溶融さ れ、被溶射物10上に皮膜が形成される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うに窒化ほう素維結体を素材として用いて完全に関心円 状構造に製造したインダクションプラズマトーチによっ て溶融粉体の溶射を行なったとしても、誘導コイル11 螺着させるとともに、前記支持体内の中間管と外側管の - 40 の下端から外側管2の下端までの距離も。があまり短い と、粉体のプラズマ炎による溶融、溶射時にプラズマト 一千外部からの低温空気による冷却凝固や酸化反応が生 じ、被溶射物10に対する溶射不良を生ずるおそれがあ

> 【0010】また、外側管2の外間に設けた誘導コイル 11の下端から被溶射物10までの距離しょが短かい場 合、プラズマ炎による粉体の溶離が充分に行なわれない ために溶射不良が生ずる。例えば、粉体としてアルミナ を用いて上配の条件で溶射した場合にはエーアルミナの 50 灰色を呈し、周囲が黒色の縞模様の皮膜しか得られなか

2/2

【0011】このような溶射不良を防止する対策とし て、外側管を長くする(即ち、誘導コイル11の下端か ら外側管2の下端までの距離し。を長くする)ことも考 えられるが、外側管2があまり長いと、トーチの下端で はシースガスとブラズマガスとが混在してしまってシー スガスによる外側管の冷却が十分に行なわれず、外側管 が過熱されて好ましくない。特にL2の距離が20m以 上になると、外側管の過熱が基だしくなり、このため外 棚管外部の酸素と外棚管の材質である窓化ほう素とが結 10 ピッチのネジである。 合して昇葉をほじめ、その結果外側管の外梁から崩れだ して、遂には外側管に穴があいてしまうという問題を引 き起こす。

[0012]

【課題を解決するための手段】この発明は上配したイン ダクションブラズマトーチにおける種々の問題点を解消 すべく検討の結果、外側管を外壁面から冷却ガスによっ て冷却するための冷却管を外側管の周囲に設けて四層構 造のプラズマトーチとするならば、外側管をたとえ長く しても外側管の過熱を防止して常に正常な溶射が可能と 20 かつ外側管および冷却管を十分長くしたことによって、 なることを見出し、この発明に至ったものである。

【0013】即ち、この発明は電化ほう素焼結体よりな り、内部に多段の関心再状類着孔を形成した円筒状支持 体に、鑿化ほう素焼結体製のキャリアガス導入管、中間 管、外側管および冷却管を順次嵌合螺蓋させるととも に、前記支持体内の中間管、外側管および冷却管の先端 に該管に対して接線方向にガスを導入するガス供給管を 嵌合総着させた四層構造であって、外側管および冷却管 の下端の位置が冷却管の外周に設けた誘導コイルの下線 から20m以上離れているインダクションプラズマトー 30 -チを提供するものである。

[0014]

【作用】この発明は、外側管の周囲に希却管を配設して キャリアガス導入管、中間管、外側管および冷却管の四 層構造のプラズマトーチとしたことによって、溶射時に 外側管をその外壁面から冷却ガスの供給によって十分に 冷却することができ、これによって外側管を長くとった 場合、即ち、誘導コイル下端から外側管および冷却管の 下端までの距離1.。を20m以上とした場合でも溶射不 とができる。

100151

【実施例】以下、この発明をその一実施例を示す図1に より詳細に説明する。なお、図1において図2と同一の 符号を付した部位は図2を参照して従来の技術の項で説 明したと同じ作用であるのでそれらの説明は省略する。

【0016】図1において、13は外郷管2の周囲に設 けた冷却管である。この冷却管13は窒化ほう素焼結体 を用いて作った円筒形状で外側管2とほぼ河長のもので あり、その先端外間に小さなピッチのネジが切られてお 50 り、支持体1の最外側の位置に挿着孔1 a と同心円状に 形成した挿着孔1jの先端に切られた小さいピッチのネ ジ14とによって押着孔1」に蝶着間定されている。

【0017】15は冷却管13と外側管2の間に外側管 2を冷却するために供給される冷却ガスの供給管であっ て、この供給管15は冷却管13支持用挿着孔11の上 方に冷却管13の内径と同じか又は若干小径にて形成さ れた締殺孔1 kにその接線方向に螺蓋されている。1 m は、この螺巻のために挿着孔1kに切られている小さい

【0018】なお、上配した挿着孔1」および1 k を支 持体内に形成するには、挿着孔1 j は外側管2挿着用の 挿着孔1cの形成についで行えばよく。挿着孔1kの形 成は挿着孔1 c の形成後に行えばよい。

【0019】かくして得られたこの発射のインダクショ ンプラズマトーチは、冷却管13、外側管2、中間管3 およびキャリアガス導入管4の各管を窒化ほう素焼結体 より製造し、これらを窒化ほう素焼結体よりなる円筒状 支持体1の内部に形成した各挿着孔に同心円状に設け、 プラズマガス供給管5からキャリアガス導入管4と中間 管3との間にアルゴンガスなどのプラズマガスを5リッ ター/分で供給し、シースガス供給管6から中間管3と 外側管2との際にアルゴンガスなどのシースガスを20 リッター/分で、また冷却ガス供給管15から冷却管1 3にアルゴンガスなどの冷却ガスを20りッター/分で 夫々供給し、キャリアガス導入管々からキャリアガスと ともに構えば粒径5~50μmのアルミナ粉体を1g/ 分供給するようしにして誘導コイルに 5 KW、 1 3. 5 6MHzの高層波を印加すると、左右によくパランスの とれた正常なプラズマ炎12が発生してアルミナ粉体が 完全に接触され、被溶射物10上に均一で熱導戦性、絶 縁性にすぐれ、耐電圧の高い皮膜を形成することができ

[0020] 上記において、外側管2および冷却管13 を誘導コイル11の下端からそれらの下端までの距離し x が30mmとなる長さとし、誘導コイル11の下端から 被溶射物10までの距離1. を75雌とした場合には被 溶射物上に均一な白色のアルミナ皮膜が形成され、また 泉の事態を招くことなく正常なプラズマ溶射を行なうこ 40 L: を55miとした場合においては灰色ではあるが総模 様のないアルミナ皮膜が形成された。

> 【0021】この発明では上記のように誘導コイルの下 端から外側管下端までの距離し。を20ms以上(好まし くは20~40mm) と長くしてシースガスとプラズマガ スが混在する領域が生じても、外側管はその外壁面から 冷却ガスによって十分冷却されるため、過大に熱せられ るという心配はない。このため外側管を構成する窒化は う素が外部の酸素と結合して昇華したりして外側管が損 傷するようなおそれは全くない。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、この発明のインダ クションプラズマトーチは、全ての部材に窒化ほう素焼 結体を用いて同心円状に嵌合螺着により構成され、かつ 外側管の周囲に冷却管を配設して四層構造としたので、 使用時に左右にバランスのとれたプラズマ炎の発生を可 能とするとともに冷却管の配設により、外側管を長くし て効率のよい粉体の熔融、溶射を行なうことができる。

【0023】また、全ての部材を窒化ほう素焼結体の切 削加工によって得ることができるので、同一寸法の部材 を容易にかつ多量に生産できること、さらに各部材は円 10 2 外側管 筒状支持体内に形成した各種着孔に同心円状に嵌合螺着 するので精度よく設計、製造することができるという多 大の効果を有するのである。なお、このインダクション ブラズマトーチに外部から力が加わり、冷却管、外側管 などが破損しても、それぞれネジが切られているので交 換も容易である。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のインダクションプラズマトーチの縦

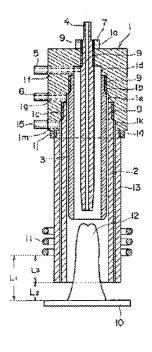
断面図である。

【図2】従来のインダクションブラズマトーチの緩断面 寒である。

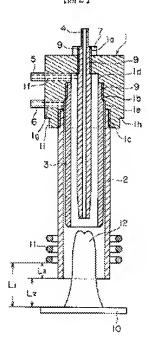
【符号の説明】

- 1 円筒状支持体
- Ia 挿着孔
- 1 b 掃着孔
- 1 c 挿袋孔
- 1) 挿着孔
- - 3 中間餐
 - 4 キャリアガス導入管
 - 9 辛ジ
 - 1.1 終漢コイル
 - 12 プラズマ炎
 - 13 冷却管
 - 14 辛ジ

[[8]1]



[2]



フロントベージの続き

(72)発明者 エミリオ 藤原

大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号 株式会社三社電機製作所内

(72) 発明者 村田 裕康

大阪府大阪市東淀川区旅路2丁目14番3号 株式会社三社電機製作所內

(72)発明者 橋 秀久

大阪府大阪市東淀川区淡路 2 丁目 14番 3 号 株式会社三社電機製作所內